

Germanium PNP Transistor

GD160


25V / 3A

DATASHEET

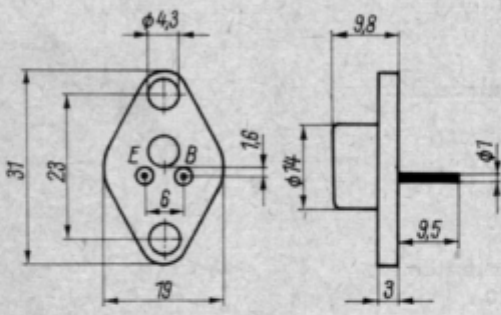
OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72

GD 160, 2-GD 160



Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11 811 für Verstärker-Endstufen und als Paare für Gegentaktstufen im Niederfrequenzgebiet sowie für Regel- und Steuerzwecke.




Masse ca. 12 g


Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	= 20 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$	= 18 V
$R_{BE} = 50 \Omega$		
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CES}$	= 20 V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 10 V
Gesamtverlustleistung	P_{VL}	= 5,3 W
Kollektorstrom	$-I_{CL}$	= 3,0 A
Emitterstrom	I_{EL}	= 3,6 A
Basisstrom	$-I_{BL}$	= 0,6 A
Sperrschichttemperatur	θ_{jL}	= +85 °C
Umgebungstemperatur	θ_{aL}	= -25 °C bis +65 °C
Wärmewiderstand	R_{thjc}	≤ 7,5 grd/W

108


KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus






GD 160, 2-GD 160

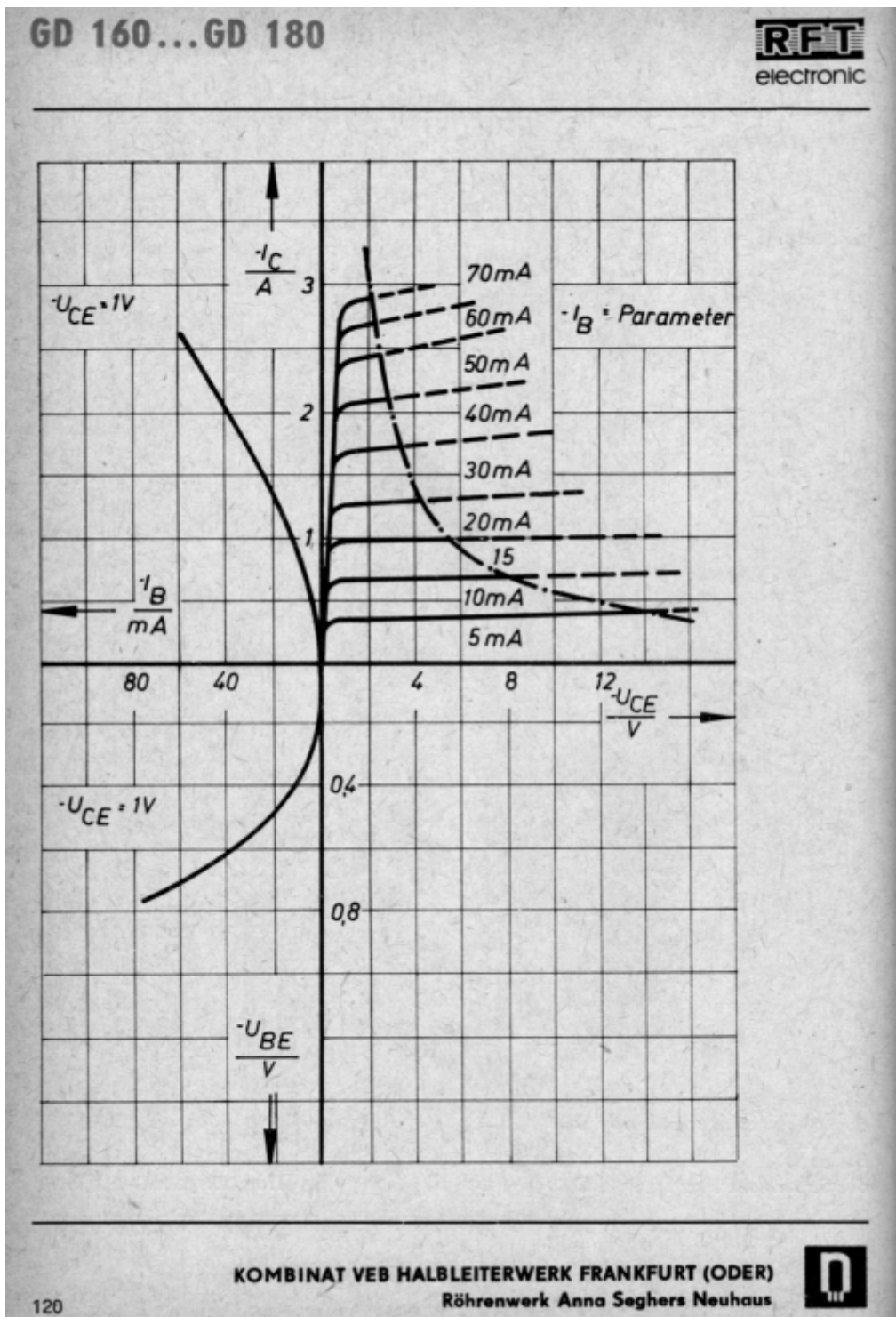
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.	
Kollektor-Basis-Reststrom -U _{CB} = 6 V	-I _{CB0}		20 μA	50 μA	
Kollektor-Emitter-Reststrom -U _{CE} = 20 V	-I _{CES}		400 μA	1500 μA	
Emitter-Basis-Reststrom -U _{EB} = 10 V	-I _{EBO}		60 μA	100 μA	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung -I _B = 0,5 A	-U _{CEsat}		0,3 V	0,6 V	
-I _C = 3 A					
Basis-Emitter-Spannung -U _{CE} = 6 V	-U _{BE}		0,35 V	0,50 V	
I _C = 0,2 A					
Basis-Emitter-Spannung -U _{CE} = 2 V	-U _{BE}		0,75 V	1,0 V	
-I _C = 1,5 A					
Dynamische Kennwerte					
Übergangsfrequenz -U _{CE} = 6 V	f _T	250 kHz			Stromverstärkungsgruppe
-I _C = 0,1 A					
Kurzschlußstromverstärkung -U _{CE} = 2 V	h _{21E}	15		30	A
-I _C = 1,5 A		24		50	B
		40		90	C
-U _{CE} = 6 V	h _{21E}	30			
-I _C = 0,2 A					
h _{21E} -Verhältnis -I _C = 1,5 A	h _{21E} 1,5	0,5			
-I _C = 0,2 A	h _{21E} 0,2				
-U _{CE} = 2 V					

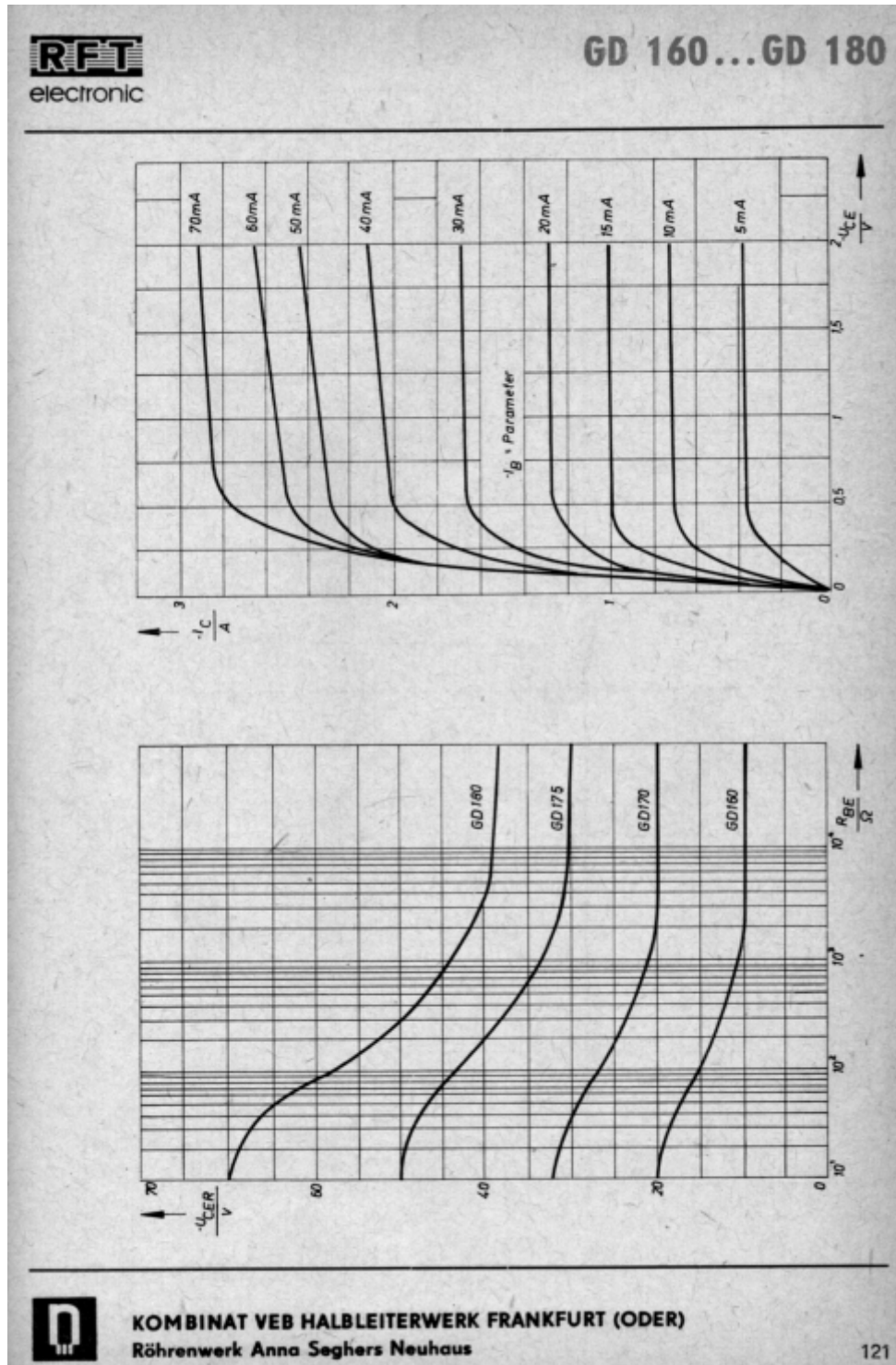


KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus

109

GD 160, 2-GD 160		RFT electronic		
		Min.	Typ	Max.
Pärchenbedingungen	I_{B1}	0,833		1,2
	I_{B2}			
$I_{B1} : -U_{CE} = 6 V$				
$-I_c = 0,2 A$				
$I_{B2} : -U_{CE} = 2 V$				
$-I_c = 3 A$				
$-U_{CE} = 2 V$	$\frac{U_{BE1}}{U_{BE2}}$	0,833		1,2
$-I_c = 3 A$				
Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe B		Transistor GD 160 B		
Bestellbeispiel für ein Transistorpaar der Stromverstärkungsgruppe B		Transistorpaar 2-GD 160 B		
110	KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus			





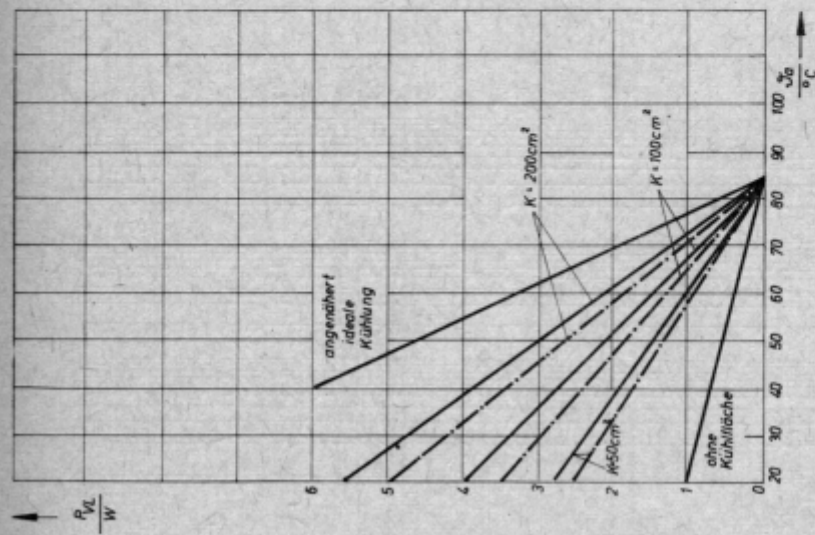
KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus

GD 160...GD 180



Kühlfläche Al 2 mm dick, blank, vertikale Lage –
 bei isolierter Montage Lackpapier 0,1 mm dick.

- direkte Montage
- · - isolierte Montage
- K = Kühlfläche



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
 Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus



